表面に於ける無輻射遷移過程

(Photo Calorimetric Detection)

東北大学工学部 近藤泰洋

はじめに

吸収された光エネルギーが結晶内で無輻射遷移より消費される際構造変化等を引き起こす場合がある。 結晶全体として収入(光吸収)と支出(フォトン、フォノン、電子、イオン等の放出)と蓄積(準安定状態)への割振りを知ることがこのような反応過程を理解する上で必要となる。 一例としてアルカリハライドの場合を挙げると、 X 線等の照射により励起子が生成された時、この励起子が緩和する分岐として自己束縛励起子(S T E) - 発光という過程及びF-H対生成が観測されている。

励起子発光の効率は励起光の波長に依存し、特に吸収係数の大きな領域で効率が減少することが知られている、この減少は励起子が結晶の表面付近で生成されるため無輻射的に再結合するためと理解されている。 西村!)はKI及びRbIに於て、STEによる発光の励起スペクトル及び反射スペクトルにみられる構造を解析し、励起子が拡散により表面に到達した場合は無輻射遷移により消滅するものとしてこれらの構造を説明すると共に吸収係数を求めた。しかし柳原ら²)によれば吸収係数の大きな領域で必ずしも発光効率の低下が見られる訳ではないことも指摘されており、表面付近での励起子の挙動(特に緩和過程)はまだ良く理解されてはいない。

励起子への表面の影響としては励起子の大きさ程度の表面数層内部での生成、結晶内部で生成された後表面への拡散の二つの場合が考えられる。 これらの影響を分離して観察するには、結晶を小さくして励起子の減衰(発光、欠陥生成及び無輻射遷移による)を観測すれば良いであるう。 その際指標となる大きさとしては励起子の拡散長及び励起子自身の大きさの二つが考えられる。

本研究では上記のような予想のもとにバルクでの性質が良く調べられているKIとAgCl(共に自己束縛励起子を形成する)を用いて、蒸着膜及びガス中蒸発による微結晶試料における励起子の発光及び無輻射遷移の効率測定及び生成された欠陥の検出を計画した。

無輻射効率の測定

吸収された光エネルギーは緩和や構造変化により一部が、また無輻射結合により全部がフォノンに変換され、試料の温度上昇に寄与する。この試料の温度上昇を検出する方法として最もよく知られているのはPAS(Photo Acoustic Spectroscopy)である。 しかし、PASは検出の手段として気体を利用しており低温での測定には向かない。 従ってここでは、赤外光検出器に用いられているボロメーターと同じ原理に従う光カロリメトリ

ックな手段を用いた。 すなはち試料の温度 上昇を高感度のゲルマニウム温度センサーで 検出する方法であり、 ポロメーターは試料 = 検出子と言う特殊な場合と見なせる。

試料及び検出子は熱容量を最小に抑えるため
0.35 K迄冷却される(~10-°J/K)。

用いたゲルマニウム抵抗の 0.35 K に於ける 抵抗値及びその温度係数は夫々、 2 k Ω、

15 k Ω / K であるから、この抵抗に1 μ A の電流を流したとき0. 1 μ V 迄の電圧変化を

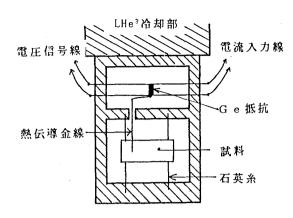


図1 光カロリメトリー分光用セル

検出し得るとすると~10⁻¹⁴ J の熱量変化を検出できる。 このエネルギーは~10⁵ フォトンであり通常の光源を用いて十分な分解能で熱発生効率スペクトルを得られる感度である。ゲルマニウム抵抗及び試料(サファイア基板)は図1の様に配置され、相互は0.1¢mmの金線で熱的に結合されている。 このシステムで試料に吸収された光エネルギーの絶対値や発生した熱量、フォノン数などの絶対値を知ることは困難である。 しかし発生した熱量(温度変化、以下ではPCSと略記する)と発光強度(以下ではLumiと略)の比、PCS/Lumiを考えると

PCS \propto natiwa -na η_L \sim ti ω_{α} -na η_{x} \cdot X Lumi \propto na η_L

と表される。 ここで $n_{\mathbf{Q}}$ は吸収されたフォトンの数、 $\omega_{\mathbf{Q}}$ 、 $\omega_{\mathbf{Q}}$ は Ω と 発光の 角周 波数、 $\sigma_{\mathbf{L}}$ は 発光の 量子 効率、 $\sigma_{\mathbf{L}}$ は 準安 定 状態 の 持つ エネルギーと その 生成 効率 を 表す。 反射 及 び 透 過 の 影 響 を 取 り 除 く た め PCSと Lumiの 比 を 考える と

PCS/Lumi \propto $\hbar \omega_{\alpha} / \eta$, $-\hbar \omega_{\rho} - (\eta_{\times} / \eta_{r}) X$

と表され PCS/Lumiは 試料に実際に吸収された光量を求める事なく得られ、 発光効率 η_L が小さくなると増加する。 また η_L が一定ならば直線となり、 η_X を無視すれば Pcs/Lumi = 0と置いて η_L を求めることが出来る。 此の光カロリメトリーによる方法は実際に吸収された光エネルギーのみに依存するため白濁した物質や彼少吸収の測定に適している。

試料

用いたKI, AgC1試料は以下の通りである。

KI 単結晶: 5 x 5 x 1 mm² AgCl 単結晶: 5 x 5 x 0.2 mm²

蒸着膜: 500A (平均膜厚, サファイア 蒸着膜: 300A (平均膜厚、

200Λ 基板) 150Λ NaCl基板)

 $50\,\Lambda$ $25\,\Lambda$

石英るつぼ中の試料をニクロム線ヒーターで加熱、膜厚モニターで平均膜厚を見ながら蒸 着を行なった。 蒸着後クライオスタットに装着するまでの数分間、 試料を空気中に晒さざ るを得ず、 目下改良中である。 AgC1蒸着膜は測定後電子顕微鏡で観察したところ、 300 A 以上の膜厚では基板を一様に覆っていたが、150A以下の膜厚では島状であった。 KI試料の電顕による観察は行ってはいない。 しかしながら、AgClからの類推から500A厚試料は薄膜、200A, 50A膜は島状の試料と思われる。

結果及び考察

1) K I

図2に単結晶試料に於て得られた STEによるπ発光の励起スペクトル、 熱 発生 (以下 P C S と略する) のスペクトル を示す。 5.9 eV付近に見られるへこみは反射 率のピークに対応し、 吸収光量の減少を示す。

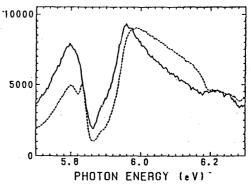


図 2 単結晶 KIの PCS (実線)、発 光励起 (点線) スペクトル

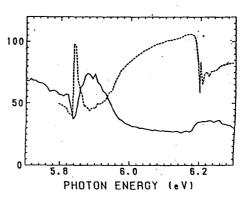


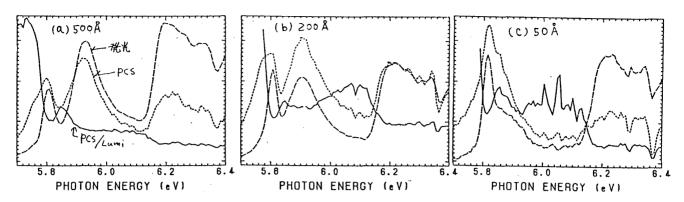
図 3 単結晶 KIの PCS/Lumi (実線) と吸収係数 (点線) のスペクトル

図4に平均膜厚 (a) 500A, (b) 200A, (c) 50Aの3試料における PCS, Lumi, PCS/Lumiの各々のスペクトルを示す。 単結晶の場合と比較してゼロフォノン線は明瞭ではないが励起子の遷移エネルギーは約0.04eVほど低エネルギー側にシフトしている。 50A 膜試料では反射によるへこみは小さく発光励起スペクトルには単結晶の吸収スペクトルに見られるゼロフォノン線に対応する遷移によると思われるピークは見られるが、 PCS/Lumiのスペクトルにおいては単結晶試料でみられた強い無輻射遷移によるピークが見られない。

LS励起子の拡散長が150 A 1)であることを考えると生成された励起子は総て発光を伴わずに無輻射的に消滅するはずであるがまだ図に示されるようにπ発光は観測されている。 おそらく発光効率の絶対値が低下し、 PCS/Lumiが平坦化していると思はれる。

2) AgC1

AgClは 520nm付近に巾の広いSTE発光を示しその発光効率は約30%である。 柳原ら2)によればAgCl直接励起子による反射ピークの補正を行って得た発光効率はKIと異なり励起子



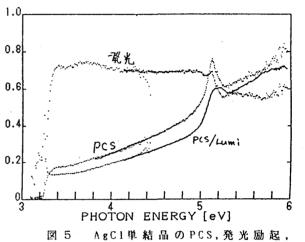
KI蒸 着膜の PCS, 発 光 励 起、 PCS/Lumiの 各 ス ペ ク ト ル。 図 4

a) 500A, b) 200A

c) 50A

ピークに於てもへこみを示さない。

図 5 に AgC1単結晶について得られたPCS. Lumi, PCS/Lumiのスペクトルを示す。 直接励 起子帯より高エネルギー側でのPCS/Lumiに見 られるステップ状の増加は此の領域より高エ ネルギー側では吸収係数が大きいためにKIの 場合と同様な表面への励起子拡散が起きてい る為と考えられる。蒸着膜試料に於ける結果 を図6に示す。 PCSに見られる励起子吸収ピー



PCS/Lumiの各スペクトル

クの位置は膜厚に依存して居らず、このサイ

ズまでの領域では励起子がまだ十分小さく励起子遷移へのサイズ効果は現れていない事を 示している。 150A以下ではPCS/Lumiスペクトルに直接励起子ピークを境にしたステップ状 の 増 加 が 見 ら れ な く な る 事 か ら 励 起 子 の 拡 散 長 は ~ 150 A 程 度 と 見 積 ら れ る。

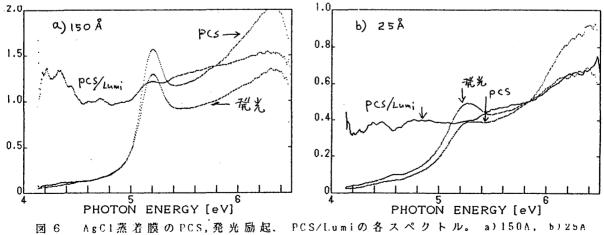


図 6

終わりに

光カロリメトリック検出法は白濁物質にも適用できることから、ただ一層では吸収強度が弱いと予想される微結晶中の欠陥の検出には積層する事により吸収強度を増加させることが出来、有効な方法と思われる。 本研究では基板上に薄く蒸着した武料についての結果を示したが、目下ガス中蒸発させた試料を基板上に厚く堆積させPCS及び発光の励起スペクトルの測定を行なう事を計画している。 これまでの測定は試料表面への拡散長程度の試料サイズについて測定を行ってきたが、励起子そのもののサイズと同程度或はそれ以下の大きさの微結晶における同様な測定及び生成された欠陥の検出を目指している。

参考文献

- 1) H. Nishimura, J. Lumin. 31, 32(1984)105.
- 2) M. Yanagihara, Y. Kondo, and H. Kanzaki, J. Phys. Soc. Jpn. 52 (1983) 4397